【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和4年4月13日(2022.4.13)

【公開番号】特開2021-64723(P2021-64723A)
【公開日】令和3年4月22日(2021.4.22)
【年通号数】公開・登録公報2021-019
【出願番号】特願2019-189278(P2019-189278)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ 29/78(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 29/12(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６５２Ｈ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６５２Ｔ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６５２Ｆ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６５２Ｓ

【手続補正書】
【提出日】令和4年4月5日(2022.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１４】
前記第２半導体部材は、
前記第２方向に沿って並ぶ複数の第１群領域と、
前記第２方向に沿って並ぶ複数の第２群領域と、
を含み、
複数の第１群領域の前記第２方向に沿うピッチは、前記複数の第２群領域の前記第２方向に沿うピッチと同じであり、
前記第１半導体部材は、
前記第２方向において前記複数の第１群領域の間の第１部分領域と、
前記第２方向において前記複数の第２群領域の間の第２部分領域と、
を含み、
前記第１部分領域から前記複数の前記第２群領域の１つへの方向は、前記第３方向に沿い、
前記複数の前記第１群領域の１つから前記第２部分領域への方向は、前記第３方向に沿う、請求項１～１３のいずれか１つに記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１６】
前記複数の第１群領域の前記１つの前記第２方向に沿う長さと、前記複数の第２群領域の前記１つの前記第２方向に沿う長さと、の和は、前記複数の第１群領域の前記１つの前記第３方向に沿う長さと、前記複数の第２群領域の前記１つの前記第３方向に沿う長さと、の和よりも短い、請求項１５記載の半導体装置。
【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
積層欠陥６０Ｓがｐ形ピラーの底部に到達すると、積層欠陥６０Ｓが拡張しなくなる。実施形態においては、複数のｐ形ピラーが第２方向Ｄ２及び第３方向Ｄ３に沿って、チェッカー状に設けられている。これにより、積層欠陥６０Ｓの拡張が、１つのｐ形ピラーの底部で停止しなかった場合も、次のｐ形ピラーの底部で停止する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
例えば、図５に示すように、複数の第１群領域６２ｐの１つの第２方向Ｄ２に沿う長さと、複数の第２群領域６２ｑの１つの第２方向Ｄ２に沿う長さと、の和は、ピッチｐｔ２に対応する。複数の第１群領域６２ｐの１つの第３方向Ｄ３に沿う長さと、複数の第２群領域６２ｑの１つの第３方向Ｄ３に沿う長さと、の和は、ピッチｐｔ３に対応する。例えば、ピッチｐｔ２は、ピッチｐｔ３よりも短い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
図６は、第１実施形態に係る半導体装置を例示する模式的断面図である。
図６は、半導体装置１１０のＤ１－Ｄ３平面における断面図である。図６に示すように、基体６６は、第１半導体部材６１に対向する面６６ａを含む。面６６ａは、第１半導体部材６１に対向する。基体６６の［１１－２０］方向は、面６６ａに対して傾斜しても良い。基体６６の［１１－２０］方向と、面６６ａと、の間の角度を角度θとする。角度θは、例えば、オフ角である。角度θは、例えば、０度を超え１０度以下である。角度θは、例えば、１度以上５度以下でも良い。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
第１電極５１にドレイン端子ＤＴが電気的に接続される。第２電極５２にソース端子ＳＴが電気的に接続される。第３電極５３にゲート端子ＧＴが電気的に接続される。